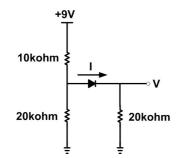
전 자 회 로 (7급)

2024년 군무원 채용시험

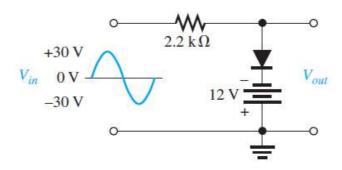
응시번호:

성명:

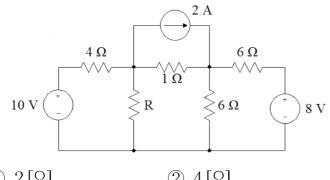
1. 다음 회로에서 전류 I[mA]와 전압 V[V] 값 으로 가장 적절한 것은? (단, 다이오드는 이상적 이다.)



- ① I = 0.25 [mA], V = 5 [V]
- ② I = 0.225 [mA], V = 4.5 [V]
- 3 I = 0.2 [mA], V = 4 [V]
- 4 I = 0.3 [mA], V = 6 [V]
- 2. 다음 회로에서 다이오드에 흐르는 피크 (peak) 순방향 전류 [mA] 값으로 가장 적절한 것은? (단, 다이오드의 순방향 전압은 0.7[V]이다.)

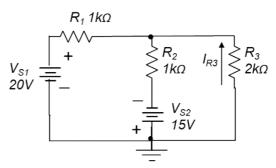


- ① 8.2 [mA]
- ② 8.5 [mA]
- $318.8 \, [mA]$
- ④ 19.1 [mA]
- 3. 아래의 회로에서 R에 최대 전력(maximum power)을 공급하기 위한 R의 값으로 가장 적절한 것은?

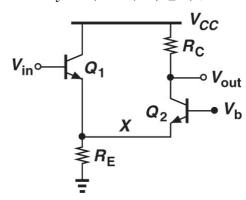


- ① $2[\Omega]$
- $24[\Omega]$
- $36[\Omega]$
- $48[\Omega]$

4. 아래의 회로에서 I_{R3} 의 값으로 가장 적절한 것은?



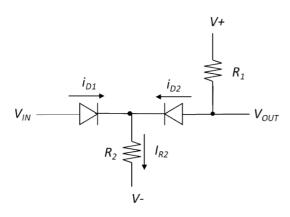
- ① 0.667 [mA]
- ② -0.667 [mA]
- ③ 1[mA]
- 4 -1 [mA]
- 5. 다음 BJT 증폭기 회로의 전압이득 관계식 Av=Vout/Vin 으로 가장 적절한 것은? (단, 모든 소자는 Early효과를 무시한다.)



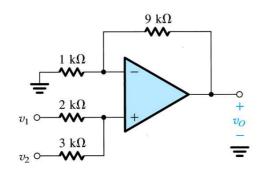
①
$$A_V = (\frac{R_E}{\frac{1}{q_{m1}} + R_E})(g_{m2}R_C)$$

②
$$A_V = -(g_{m1}R_E)(g_{m2}R_C)$$

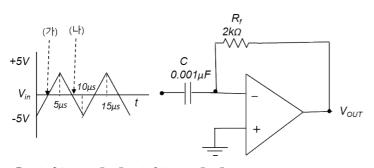
6. 다이오드의 순방향 전압 강하는 0.7[V]라고 가정하고, 9. 아래의 CMOS(Complementary MOSFET) 회로가 $V = 5 [V], V = -5 [V], R_1 = 5 [k\Omega], R_2 = 10 [k\Omega],$ $V_{\rm IN}$ =4[V] 일 때, $I_{\rm Dl}$ 과 $I_{\rm D2}$ 의 값에 가장 가까운 것은?



- ① $I_{D1} = 0.83 [mA]$
 - $I_{D2} = 0.2 [mA]$
- ② $I_{D1} = 0 \text{ [mA]}$
- $I_{D2} = 0.83 [mA]$
- $\Im I_{D1} = 0.63 [mA]$
- $I_{D2} = 0.2 [mA]$
- 4 $I_{D1} = 0.63 [A]$
- $I_{D2} = 0 [mA]$
- 7. 다음 증폭기 회로의 출력 전압 v_o 로 가장 적절한 것은? (단, 연산증폭기는 이상적이다.)

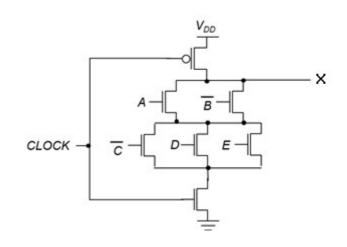


- ① $v_o = 2v_1 + 3v_2$
- ② $v_o = 4v_1 + 3v_2$
- $v_0 = 3v_1 + 4v_2$
- $v_0 = 6v_1 + 4v_2$
- 8. 이상적 (ideal) OP-amp를 가정하고 V_{IN}에 아래 그림과 같은 삼각파가 입력되었다고 할 때, 시간 t의 (가)영역과 (나)영역에서의 Vour 값으로 가장 적절한 것은?

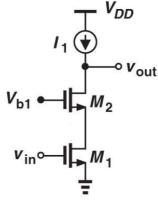


- ① (가) -2[V], (나) +2[V]
- ② (가) -4[V], (나) +4[V]
- ③ (가) +4[V], (나) -4[V]
- (4) (7) +2[V], (4) -2[V]

출력 X에서 구현하는 함수와 등가인 논리회로로 가장 적절한 것은?

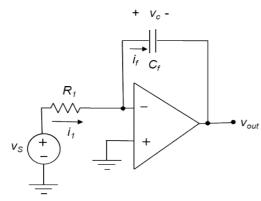


- $(1) (A + \overline{B}) \bullet (\overline{C} + D + E)$
- ② $(\overline{A} \cdot B) + (C \cdot \overline{D} \cdot \overline{E})$
- $(3) (A \cdot \overline{B}) + (\overline{C} \cdot D \cdot E)$
- $\textcircled{4} (\overline{A} + B) \bullet (C + \overline{D} + \overline{E})$
- 10. 아래 증폭기 구조에 대한 설명으로 가장 적절 하지 않은 것은?



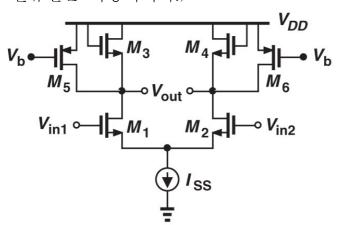
- ① 동일한 바이어스 조건에서 공통 소스 증폭기 보다 큰 출력 저항을 갖는다.
- ② 동일한 바이어스 조건에서 공통 소스 증폭기 보다 큰 전압 이득을 갖는다.
- ③ 동일한 바이어스 조건에서 고주파 동작 시 공통 소스 증폭기보다 안정성(stability)이 우수 하지 못하다.
- ④ 동일한 바이어스 조건에서 고주파 동작 시 공통 소스 증폭기보다 밀러효과(Miller effect) 현상을 억제할 수 있다.

11. 다음 보기 중 아래의 회로에서 v_s 와 v_{out} 의 관계식으로 가장 적절한 것은? (단, 캐패시터는 초기에 방전되어 있다고 가정한다.)



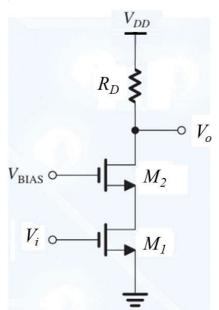
②
$$v_{out}(t) = -\frac{1}{R_1 C_f} \int_0^t v_s(t) dt$$

12. 다음 CMOS 차동 증폭기 회로의 전압이득 관계식 Av=Vout/Vin으로 가장 적절한 것은? (단, 회로는 완벽한 좌우 대칭을 이루고 있으며, 모든 소자는 채널길이변조를 고려한다. 또한, 전류원은 이상적이다.)



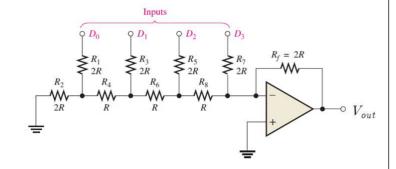
②
$$A_V = -g_{m1}(r_{o1}||r_{o5}||r_{o3})$$

13. 다음 MOSFET 증폭기 회로의 전압이득 $A_v = V_o/V_i$ 의 값으로 가장 적절한 것은? (단, MOSFET M_1 과 M_2 의 g_{m1} 과 g_{m2} 는 전달컨덕턴스이며, r_{o1} 와 r_{o2} 는 소신호 출력저항이고, 몸체효과와 기생커패시턴스 성분은 무시한다. V_{BIAS} 는 M_2 가 포화영역에 동작하도록 바이어스 되어 있다고 가정한다.)



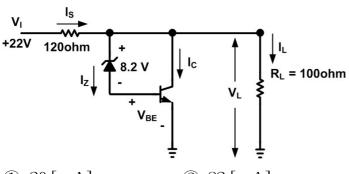
$$\bigcirc \frac{g_{m1}R_D(g_{m2} + \frac{1}{r_{o2}})}{g_{m2} + \frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}} + \frac{R_D}{r_{o1}r_{o2}}}$$

14. 다음 회로에서 디지털 입력이 $D_3 = 0$, $D_2 = 0$, 16. 아래 회로에서 resonance frequency가 18 [kHz] D_1 = 1, D_0 = 0일 때 출력 전압 V_{out} [V]의 값으로 가장 적절한 것은? (단. 디지털 입력이 "1"은 +5 [V]. "0"은 0 [V]를 의미하고, 연산증폭기는 이상적이다.)



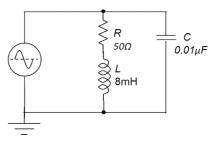
- ① -0.0625 [V]
- ② -1.25 [V]
- 3 -2.5 [V]
- 4 -5[V]

15. 다음 회로에서 흐르는 전류 I_C [mA]값으로 가장 적절한 값은? (단, 트랜지스터 소자의 V_{BE} 는 0.7[V]이고, $I_Z \ll I_C$ 이다.)

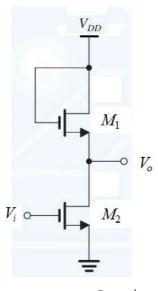


- ① 20 [mA]
- ② 82 [mA]
- ③ 89 [mA]
- 4) 109 [mA]

일 때, 임피던스 값으로 가장 적절한 것은?

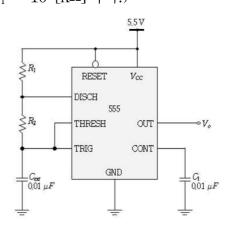


- ① $16 [k\Omega]$
- ② $24 [k\Omega]$
- $35 [k\Omega]$
- Φ 52 [kΩ]
- 17. 다음 MOSFET 증폭기회로에서 전압이득 A_v = $|V_o/V_i|$ 의 값으로 가장 적절한 것은? (단, MOSFET M_1 과 M_2 는 동일하고, 각 MOSFET의 전달 컨덕 턴스는 g_m 이며, 채널변조효과는 무시한다.)



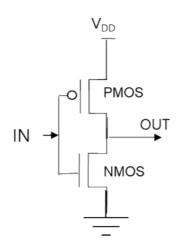
1

- ② $1/g_m$
- \mathfrak{G}_m
- (4) g_m^2
- 18. 다음은 비 안정 모드로 동작하는 555 타이머 회로이다. 출력 신호 V_0 의 듀티 사이클 60[%]로 동작하게 하는 $R_2[\mathbf{k}\Omega]$ 값으로 가장 적절한 것은? $(단, R_1 = 10 [k\Omega]$ 이다.)

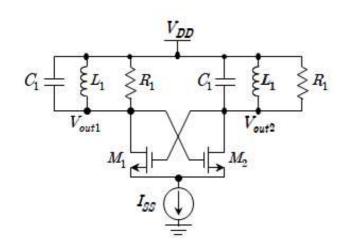


- ① $5[k\Omega]$
- ② $10[k\Omega]$
- $3 20 [k\Omega]$
- 4 30 [kΩ]

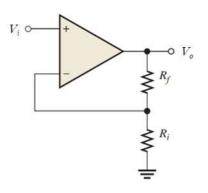
voltage는 1V이고 PMOS는 -1[V]라고 하고, V_{DD}는 5 V이다. 이때 게이트 입력이 1.5[V]라면, PMOS와 NMOS의 동작 모드를 가장 적절하게 표현한 것은? (단, long channel transistor model을 가정한다.)



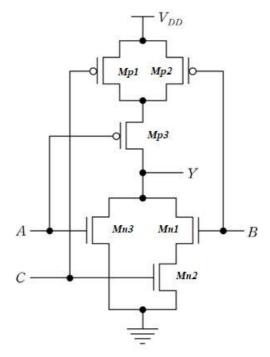
- ① PMOS: linear, NMOS: linear 2 PMOS: off, NMOS: saturation 3 PMOS: saturation, NMOS: linear
- 4 PMOS: linear, NMOS: saturation
- 20. 다음 병렬 LC 탱크를 이용한 교차 결합 발진기 회로에서 발진하기 위한 저항 조건으로 옳은 것은? (단, M_1 과 M_2 는 동일한 MOSFET이고. g_m 은 MOSFET M_1 과 M_2 의 전달컨덕턴스이며, 채널길이변조와 몸체효과는 무시한다.)



19. 아래 CMOS 인버터회로의 NMOS의 threshold 21. 다음 연산증폭기 회로의 대역폭(bandwidth) [kHz]으로 가장 적절한 것은? (단, 연산증폭기의 개루프 이득은 100 [dB]이고 대역폭은 50 [Hz] 이며, $R_i = 2 [k\Omega]$ 이고 $R_f = 98 [k\Omega]$ 이다.)

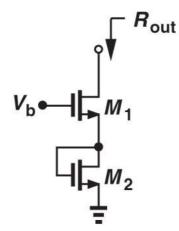


- ① 50 [kHz]
- 2 100 [kHz]
- ③ 500 [kHz]
- 4 1000 [kHz]
- 22. 다음 CMOS 논리회로에서 각 트랜지스터별 채널폭대 채널길이 비(W/L)로 가장 적절한 것은? (단, 이 논리회로는 기본 인버터 회로의 전류 구동능력과 동일하게 선택되어야 하며, 기본 인버터의 NMOS의 W/L은 1이고, PMOS의 W/L은 2라고 가정한다.)



- ① $(W/L)_{Mp1} = 2$, $(W/L)_{Mp2} = 2$, $(W/L)_{Mp3} = 2$, $(W/L)_{Mn1} = 1$, $(W/L)_{Mn2} = 1$, $(W/L)_{Mn3} = 1$
- ② $(W/L)_{Mp1} = 4$, $(W/L)_{Mp2} = 2$, $(W/L)_{Mp3} = 2$, $(W/L)_{Mn1} = 1$, $(W/L)_{Mn2} = 1$, $(W/L)_{Mn3} = 2$
- ③ $(W/L)_{Mp1} = 4$, $(W/L)_{Mp2} = 4$, $(W/L)_{Mp3} = 2$, $(W/L)_{Mn1} = 1$, $(W/L)_{Mn2} = 1$, $(W/L)_{Mn3} = 2$
- 4 $(W/L)_{Mp1} = 4$, $(W/L)_{Mp2} = 4$, $(W/L)_{Mp3} = 4$, $(W/L)_{Mn1} = 2$, $(W/L)_{Mn2} = 2$, $(W/L)_{Mn3} = 1$

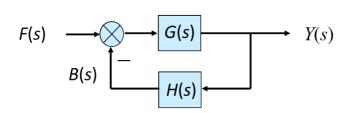
23. 다음 회로에서 출력 저항의 표현식으로 가장 적절한 것은? (단, 모든 소자는 채널길이변조를 고려한다.)



①
$$R_{out} = r_{o2}(1 + g_{m2}(\frac{1}{g_{m1}}||r_{o1})) + \frac{1}{g_{m1}}||r_{o1}|$$

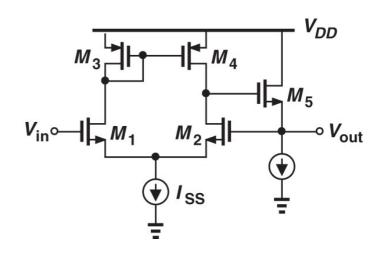
②
$$R_{out} = r_{o2}(1 + g_{m2}r_{o1}) + r_{o1}$$

24. 아래의 closed-loop diagram에서의 transfer function (전달함수)으로 가장 적절한 것은?



- $4) \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$

25. 다음 궤환증폭기 회로의 페루프 이득 관계식 Vout/Vin으로 가장 적절한 것은? (단, 전류원은 모두 이상적이며, 모든 소자는 채널길이변조를 고려한다.)



$$\textcircled{1} \ \, \frac{|Vout|}{|Vin|}|_{closed} = \frac{g_{m1}(r_{o2}||r_{o4})(\frac{g_{m5}r_{o5}}{1+g_{m5}r_{o5}})}{1+g_{m1}(r_{o2}||r_{o4})(\frac{g_{m5}r_{o5}}{1+g_{m5}r_{o5}})}$$

$$@ \frac{Vout}{Vin}|_{closed} = - \frac{g_{m1}(r_{o2}||r_{o4})(\frac{g_{m5}r_{o5}}{1 + g_{m5}r_{o5}})}{1 + g_{m1}(r_{o2}||r_{o4})(\frac{g_{m5}r_{o5}}{1 + g_{m5}r_{o5}})}$$